

а 2007 0306

Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности, к случайным микролазерам, которые могут быть использованы в спектроскопии, медицинской диагностике, производстве дисплеев и др.

Способ получения случайного микролазера включает легирование пористого полупроводникового темплата пиролизом предшественников соединений редкоземельных или переходных металлов с одновременным окислением его. Для этого темплат пропитывают водным раствором указанных предшественников, после чего его подвергают термической обработке в течение часа при температуре до 1200°C, в атмосфере, образованной из инертного газа с добавкой кислорода.

П. формулы: 1

Фиг.: 5